⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出頭公開

平3-96266 ⑩公開特許公報(A)

識別配号

В

庁内整理番号

7638-5F

@公開 平成3年(1991,4月22日

25/00 H 01 L

7638-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

半導体集積回路モジュール 会発明の名称

到特 頤 平1-234341

頭 平1(1989)9月8日

兵庫県伊丹市瑞原 4丁目 1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

三菱電機株式会社 の出 類

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 增雄 外2名 四代 理 人

1. 発明の名称

半導体単位回路モジュール

2. 特許請求の範囲

半導体集積回路装置としてのチップが内蔵され た能動部品と、コンデンサ等の受動部品とが複数 例、同一基板に配されて構成される半導体集数回 路モジュールであって、

前記チップが所定の外弧器で封止されることに よって、規格化された単位として構成された能動 ユニットと、

所定の母材を用いて前記受動部品が前記能動ユ ニットと同一の単位に規格化された受動ユニット ٤.

前記能動ユニットと前記受験ユニットとが同一 の配列でその上に並べられた甚反とを見える、半 遊び負債回路モジュール。

3. 発明の詳細な説明

【弦楽上の利用分野】

この免明は、半導体単数回路モジュールに関し、

特に、半導体集積回路装置としてのチップが内蔵 された能動部品と、コンデンサ等の交動部品とが 複数例、同一基板に配されて構成される半導体集 貧回路モジュールに関するものである。

[従来の技術]

第9AMは、従来の半導体災益回路モジュール の一例としてメモリモジュールを示す正面図、第 9B凶は、その関面凶である。 凶示されたメモリ モジュール1は、メモリ102が高さ方向に数上 げられて紅立てられており、最も平面火装出皮の **ざいメモリモジュールである。メモリICチップ** のパッケージングが完了したメモリ1C2は、2 つのプリント基氨3の間に挟まれて並べられてい る。そのプリント芸灰3に及けられたスルーホー ル6に、メモリ1C2の外部リード7が挿入され ている。外なリード7とスルーホール6とは半田 付けで技装協定されている。このようにして、複 **数似のメモリIC2が担立てられた後、コンデン** サラがプリント及収3の所定位置に手作業で半田 付けされて取付けられる。その収付位収は、回路 上で決定され、プリント基数3の上で配置できるように改定される。コンデンサらは、限型的には各メモリ1C2に対し、その電源な子の副及に配置される。それにより、電源に存在するノイズが除立される。すなわち、ノイズ対策のためにコンデンサラがメモリモジュール1に組込まれる。ブリント基数3にはクリップリード4が取付けられている。このクリップリード4とスルーホール6とは、所定のモジュールの機能に応じてプリント基数3の上に形成されたみ体パクーン(図示せず)によって接続されている。このようにして、パーソナルコンピューク等に設けられる増設メモリとしてのメモリモジュール1が組立てられる。

[允明が解決しようとする深道]

従来のメモリモジュールは以上のように構成されているので、コンデンサは、メモリ I C が取付けられるプリント 基板の取付面とは反対例に配置されている。そのため、メモリ I C と同時に 机立てることができないので、コンデンサの取付作業は手作業となる。また、メモリモジュールが基板

に取付けられて実装されるときに、その基板内で メモリモジュールが占有する面積、すなわち平面 実装密度が、第9B図に示されるようにコンデン サの厚み分、悪くなる等の問題点があった。

そこで、この発明は、上述のような問題点を解析するためになされたもので、半導体集積回路袋 置としてのチップが内蔵された能動部品と関係の 取扱いでコンデンサ等の受動部品を組立てることができるとともに、平面実装出皮を低下させることのない半導体集積回路モジュールを提供することを目的とする。

[環題を解決するための手段]

この免別に従った半導体集積回路モジュールは、 能動ユニットと、受動ユニットと、 基板とを得え る。 能動ユニットは、半導体集積回路 突襲として のチップが所定の外側器で封止されることによっ て、 規格化された単位として構成される。 受動ユニットは、 所定の部材を用いて受動部品が能動ユニットと同一の単位に 規格化されたものである。 能動ユニットと受動ユニットとが同一の配列で返

板の上に並べられている。

re:m1

この発明においては、受動部品は能動ユニットと同一の単位に規格化されている。その規格化された受動ユニットと能動ユニットとが、基板の上に同一の配列で並べられる。そのため、半導体集積回路モジュールの組立時において、コンデンサ等の受動部品を能動部品と同様に取扱うことができる。したがって、受動部品が基板の上で別に配置されることがないので、平面実装密度を低下させることもない。

【免明の実施例】

以下、この免別の一実施料を図について設別する。第1A図は、この免別に従った半等体集裁別路モジュールの一例としてメモリモジュールを示す正面器である。第1B図は、その側面図である。メモリICチップが所定のパッケージで対止されたメモリIC2は、2つのプリント基板3の間に挟まれて並べられている。また、複数偶のコンデンサが所定のパッケージに内蔵されることによっ

て、メモリIC2と同一の単位に現格化されたコンデンサアレイ8は、メモリIC2と同一の配列でプリント基板3の間に並べられている。プリント基板3に設けられたスルーホール6には、メモリIC2の外部リード7と、コンデンサアレイ8の外部リード12とが挿入されている。スルーホール6と外部リード7.12とは半田付けで接続固定されている。スルーホール6と、プリント基板3の一位に取付けられたクリップリード4とは、所定のモジュールの機能に応じてプリント基板3の上に形成された事体パターン(図示せず)を介して接続されている。このようにして、メモリモジュール13が構成される。

この免別のメモリモジュール13に頼込まれたコンデンサアレイ8の構造について説明する。第2A図は、コンデンサアレイ8を示す正面図である。第2B図は、その舞面図である。第2C図は、第2A図のIC-IIC線における版面図である。これらの図を参照して、複数個の単体のコンデンサ10が、リードフレームのインナーリード11

計開平3-96266(3)

に半川103等の専選性の良好な接近材料を用いて設付けられている。コンデンサの資益器にはコンデンサ選値104が設けられている。このコンデンサ選艦104がインナーリード11に接続されている。インナーリード11から延びるように外部リード12が形成されている。コンデンサアレイ8の外形は、対止以前9によってメモリIC2と同一の外形に成形されている。

第3 A 図~第3 D 図は、この発明のメモリモジュールに組込まれるコンデンサアレイ8の製造方法の一例を工程順に示す斜段図である。以下、これらの図を参照して、コンデンサアレイ8の製造方法について説明する。第3 A 図を参照して、コンデンサアレイ製造用のリードフレーム101が準備される。第3 B 図に示すように、予め収録された単体のコンデンサ10が、リードフレーム101のインナーリード11に半凹103等の得電性が良好な接近材料を用いて取付けられる。図には、コンデンサ10がリードフレーム101のインナーリード11の間にまたがるように裁型され

た状態が示されている。その後、第3C図を参照して、対比以前9によってメモリICと同一の外形に成形される。さらに、第3D図に示すように、不要な対止樹脂(外部リード間で)が除去される。外部リード12には、メモリモジュールとして和立てられる数に半田付けを容易にするための外域がっきが論される。その後、リードフレーム枠部102と不要部分でが切断される。最後に、外部リード12が所定の形状に加工されることにより、第2A図、第2B図に示されるようなコンデンサフレイ8が完成する。

なお、メモリIC2の構造は第4A図、第4B 図に示されている。メモリICチップ201の周 辺鏡域に設けられた各電磁202には、インナーリード204が金線203を介して電気的に使続されている。外窓リード7のみが外側に見われるように、メモリIC2の外形は、対止関係9によって成形されている。

メモリIC2とコンデンサアレイ8とは以下のようにして机立てられる。 第5AMは、メモリモ

ジュールの組立に別いられるブリント 茲仮3を示 す例面図である。 郊5B凶は、その平面凶である。 プリント基反の表面上には所定の配列に従ってス ルーホール6が形成されている。プリントな収3 の一端部には、クリップリード半四付け用電極3 ○1が形成されている。 第6世は、メモリモジュ ールの分解和立例面図である。多数例のメモリ1 C 2とコンデンサアレイ8とが1列に並ぶように Q血ねられる。メモリ1C2の外体リード7と、 コンデンサアレイ8の外部リード12が、矢印で 示される方向にプリント甚収3のスルーホール6 に挿入される。外部リード12とスルーホール6 とは、フローソルダリング等の方法を用いて半田 付けされる。クリップリード4は、矢印で示され . る方向に、プリント基反3の電艦301に延入さ れた後、半田付けされる。このとき、クリップリ ード4は、第7凶で示されるようななな形状を斤 するので、ばね力によって容易に電腦301に圧 人される。このようにして、郊1A凶、郊1B凶 に示されるようなメモリモジュール13が完成す

δ.

なお、上記実施例においてはコンデンサ10は 所定のパッケージに封止されることによってメモ リIC2と同一の単位に規格化されている。しか しながら、第8A図、第8B図に示されるように、 プリント仏板上にコンデンサを配列させることに よって、メモリICと同様の収扱いができるよう にコンデンサが所定の単位に規格化されてもよい。「 このとき、コンデンサアレイはメモリICと異な る外形を有するが、外形寸法、取付寸法として一 定の規格化された寸法を有すればよい。 第8A凶 は、コンデンサアレイの別の実施例を示す正面凶 である。 58.8 図は、その側面図である。 プリン ト基板14の上に所定の配列に従って複数個のコ ンデンサ10が収付けられている。ブリント基収 14の背流部分には外部リード15が设けられて いる。外部リード15と各コンデンサの電極とは、 プリント基板14上に設けられた配線パターン (付示せず) を介して接続されている。このよう にして、コンデンサアレイ18が構成されている。

持周平3-96266 (4)

また、上記実施例においては、交換な品として コンデンサの例を帯げて説明しているが、コンデ ンサ以外の低抗器等がメモリーCと同一の単位に 現物化されてもよい。

さらに、上記実施資においては、半導体集数回 路袋畳としてメモリ I Cを用いているが、メモリ 以外の機能を有する I Cが用いられてもよい。 【免引の効果】

以上のように、この免別によれば、交動部品が 能動部品と同一の単位に以格化されて、同一の配 列で基板の上に並べられるので、半等体類数回路 モジュールを和立てる数の工程が飼略化される。 また、半等体集級回路モジュールの実装衛度を向 上させることが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

第1A図は、この発明に従った半部体集級回路 モジュールの一例としてメモリモジュールを示す 正面図である。

第18図は、この発明に従った半導体集数回路 モジュールの一例としてメモリモジュールを示す 餌面悶である。

第28関は、コンデンサアレイを示す側面図で ある。

第20回は、第2A回のEC-EC数における 新値図である。

第3A図、第3B図、第3C図、第3D図は、 この免別のコンデンサアレイの製造方法を工程順 に示す料製図である。

郊4A図は、能動ユニットの一例としてメモリ I Cを示す正面図である。

郊4 B 図は、メモリICを示す側面図である。 第 5 A 図は、メモリモジュールの和立てに用い られるブリントな板を示す側面図である。

第5B図は、メモリモジュールの和立に用いられるプリント基板を示す正面図である。

第6 図は、この発明のメモリモジュールを概略 的に示す分解和立側面図である。

第7団は、プリント基板の一端部に設けられる クリップリードの詳細を示す部分科技図である。

類8A図は、コンデンサアレイの別の実施費を 示す正面図である。

郊 8 8 凶 は、コンデンサアレイの別の実験例を 示す朝崎凶である。

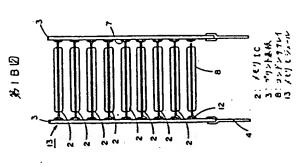
339 A 図は、従来の半導体集積回路モジュールの一例としてメモリモジュールを示す正面図である。

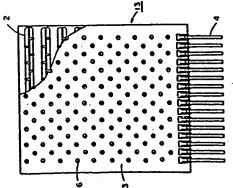
第9日図は、従来の半導体集積同路モジュールの一例としてメモリモジュールを示す側面図である。

図において、2はメモリIC、3はプリントは 安、8はコンデンサアレイ、13はメモリモジュ ールである。

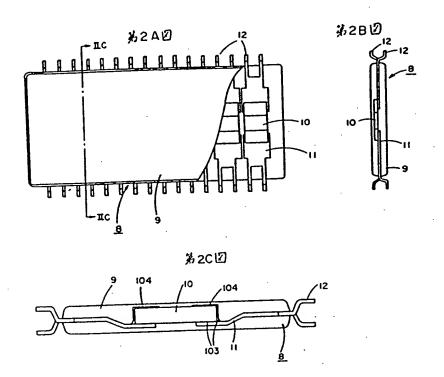
なお、各図中、同一符号は同一または相当部分 を示す。

化班人 火岩岩堆

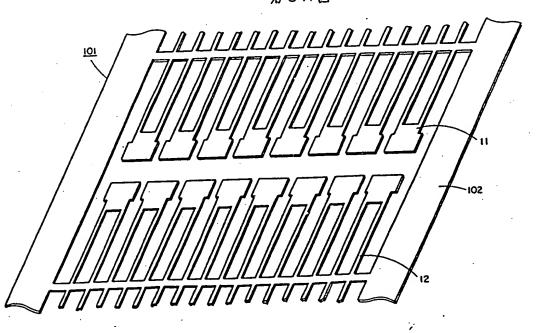




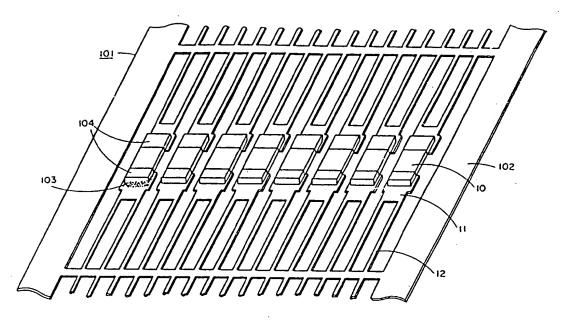
特開平3-96266(5)



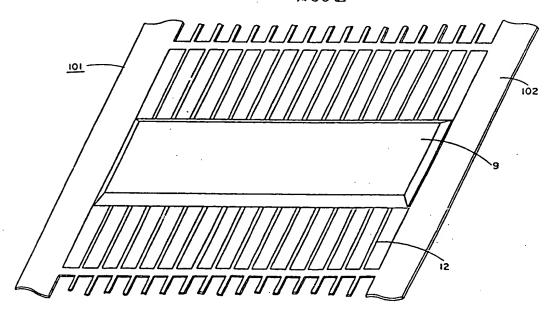
第3A囚

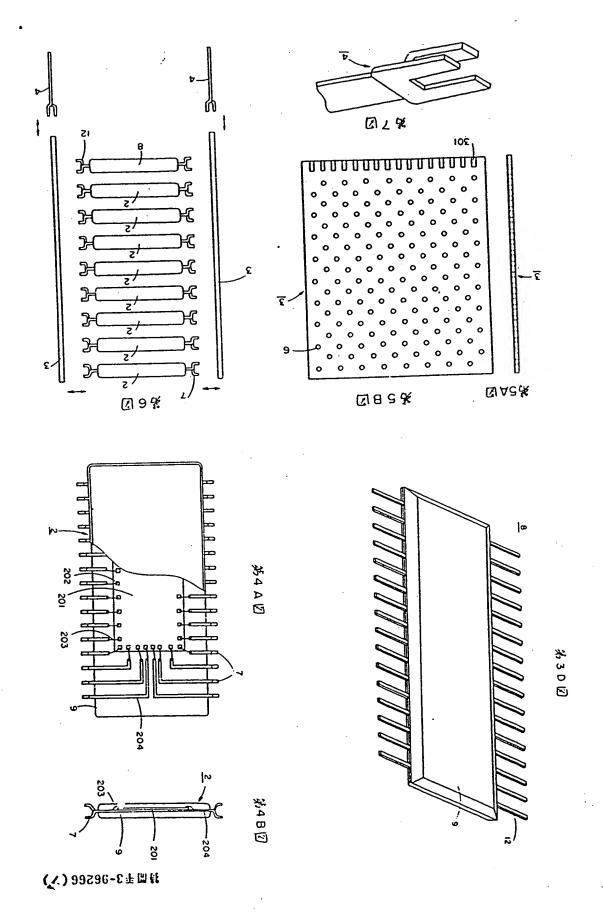


药3B图

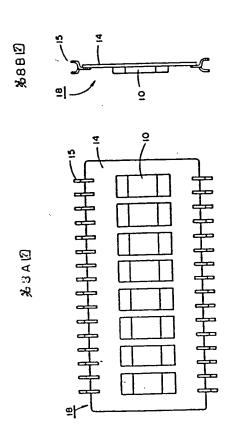


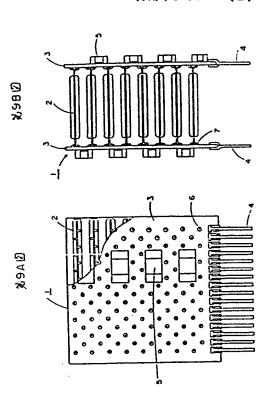
第3C 図





特開平3-96266(8)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.